20p-F8-4

外部変調・半導体全光ゲート型モードロックパルスレーザの 外部変調度微弱化

All-optical-gate-type mode-locked few-picosecond pulsed laser with externally injected, weakly modulated optical seed 電気通信大学¹, °長広 憲幸¹, 中根 隆晃¹, 板垣 元¹, 渋谷 俊憲¹, 平井 恭兵¹, 上野 芳康¹ Univ. of Electro-Communications¹, °Kazuyuki Nagahiro¹, Takaaki Nakane¹, Hajime Itagaki¹, Toshinori Shibuya¹, Kyohei Hirai, Yoshiyasu Ueno¹, E-mail: <u>ueno@ee.uec.ac.jp</u>

1. 序論

 光クロックパルスは、光時分割多重通信
(OTDM)方式^[1,2]、光ファイバ断線位置計測
(OTDR)^[3]、希薄分子分光等に有用である。 遅延干渉型全光ゲート DISC^[4,5]を応用した
DISC-loop 型光パルス発生器^[6]では、中心波
長・パルス幅・繰り返し周波数を任意設定可能

である。他方、外部入力に連続光を用いる当初 方式^[6]では、発振調整過程でQスイッチによる 高エネルギーパルスが発生して半導体光増幅 器(SOA)を損傷する危険性があった。その後、 Qスイッチの発生を防止するために外部変調 方式^[7]に移行したところ、外部変調を強めると 出力にサブパルスが混ざり^[8]、外部変調を弱め るとモードロックパルス発振が停止するとい う課題が現れた^[9]。

本研究では、外部変調を段階的に弱め、モードロックパルス発振状態を調べた。

外部変調 DISC-loop 型パルスレーザ構成 実験構成を Fig.1 に示す。外部光源出力光を 電界吸収型変調器 (EAM) で強度変調し、 DISC-loop に入力した。変調周波数はエネルギ 一分配用 MZI の FSR(=10.5 GHz)に合わせた。 DISC 内部 MZI 遅延時間は、2.3 ps に設定した。

EAM 駆動用 RF amp の利得を増減させ、外部変調光の変調度を増減した(Fig.2(a))。EAM 出力後の光変調度を、最初 31%以上に設定し、 モードロックパルス発振させた。その上で、変調度を段階的に弱めながら、モードロックパル ス発振状態を調べた。



3. モードロック状態の外部変調度依存性

Fig. 2(b)に、EAM 出力光信号を示す。Fig.3 は DISC-loop 出力パルス波形である。出力消光 比は変調度 31%では 7.8 dB、6.8%では 8.4 dB であった。変調度を弱めると、サブパルスが抑



時間帯域幅積(t・f 積)は変調度 31%では 0.52 だが、6.8%では 1.89 に悪化した。また、出力 消光比が不安定な状態が続いた。これらの原因 は実験環境の温度変化などと考えられ、今後調 査する予定である。



4. 結論

DISC-loop型パルス発生器において、発振調 整過程のQスイッチ発生を防止するために強 い変調度でパルス発振させ、その状態から変調 度を弱めてモードロック状態を保つことがで きた。変調度微弱化はサブパルス低減に有効で あった。モードロックパルス発振の不安定性、 t・f 積増大、およびパルス幅増大の原因を今後 調査する予定である。

引用文献

[1] K.E.Stubkjaer et al., IEEE JQE, vol.6, (2000) 1428.

- [2] S.A.Hamilton et al. IEEE JLT, vol.20, (2002) 2086.
- [3] 美濃島, 精密工学会誌 vol.72, (2006) 959.
- [4] Y. Ueno et al., IEEE PTL, vol. 10, (1998) 346.

[5] Y. Ueno et al,. Invited Talk, ssdm, Tokyo, Sept. 2010.

[6] R. Suzuki et al., CLEO, No. CMG5 (2006).

[7] S. Yan et al., opt. com., 283 (2010) 87-92.

[8] 新井他, 第 58 回応用物理学会関係連合講演会, 24a-KA-9 (2011).

[9] 平井他, 第 60 回応物春季学術講演会, 29p-B3-4 (2013).